

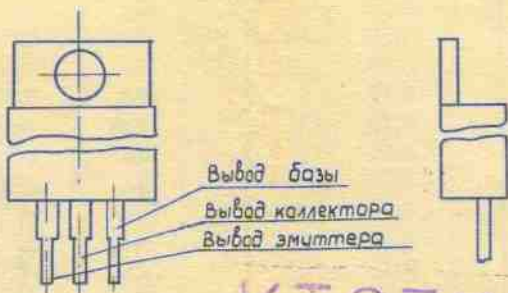


ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ

КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Г,
КТ837Д, КТ837Е, КТ837Ж, КТ837И,
КТ837К, КТ837Л, КТ837М, КТ837Н,
КТ837П, КТ837Р, КТ837С, КТ837Т,
КТ837У, КТ837Ф

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-диффузионные р-п-р усилительные низкочастотные транзисторы типов КТ837А-КТ837Ж, КТ837И-КТ837Н, КТ837Л-КТ837Р в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения и другой аппаратуры. Климатическое исполнение УХЛЗ.



КТ837А

50

ОКТАБРЬ 1989

Масса не более 2,5 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{\text{корп.}} = (+25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Т и п транзистора	Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, буквенное обозначение, Норма							
	Обратный ток коллектора, мА, $I_{КЭ0}$ при $U_{КЭ} = 80$ В для КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Л, КТ837М, КТ837Н; $U_{КЭ} = 60$ В для КТ837Т, КТ837Д, КТ837Е, КТ837Л, КТ837Р, КТ837С; $U_{КЭ} = 45$ В для КТ837Ж, КТ837И, КТ837К, КТ837Т, КТ837У, КТ837Ф	Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, $I_{КЭР}$ при $R_{ЭБ} = 50$ Ом, $U_{КЭ} = 70$ В для КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Л, КТ837М, КТ837Н; $U_{КЭ} = 55$ В для КТ837Т, КТ837Д, КТ837Е, КТ837Л, КТ837Р, КТ837С; $U_{КЭ} = 40$ В для КТ837Ж, КТ837И, КТ837К, КТ837Т, КТ837У, КТ837Ф	Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, $I_{КЭ0}$ при $R_{ЭБ} = \infty$, $U_{КЭ} = 60$ В для КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Л, КТ837М, КТ837Н; $U_{КЭ} = 45$ В для КТ837Т, КТ837Д, КТ837Е, КТ837Л, КТ837Р, КТ837С; $U_{КЭ} = 30$ В для КТ837Ж, КТ837И, КТ837К, КТ837Т, КТ837У, КТ837Ф	Обратный ток эмиттера мА, $I_{Э0}$ при $U_{ЭБ} = 15$ В для КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Т, КТ837Д, КТ837Е, КТ837Ж, КТ837И, КТ837К, $U_{ЭБ} = 5$ В для КТ837Л, КТ837М, КТ837Н, КТ837Л, КТ837Р, КТ837С, КТ837Т, КТ837У, КТ837Ф	Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, $h_{21Э}$, (при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 2$ А)		Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $U_{КЭнас}$ при $I_K = 3$ А, $I_B = 0,37$ А для КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Т, КТ837Д, КТ837Е, КТ837Л, КТ837М, КТ837Н, КТ837Л, КТ837Р, КТ837С; $I_K = 2$ А, $I_B = 0,3$ А для КТ837Ж, КТ837И, КТ837К, КТ837Т, КТ837У, КТ837Ф	Напряжение насыщения база-эмиттер, В $U_{БЭнас}$ (при $I_K = 2$ А, $I_B = 0,5$ А)
	не более	не более	не более	не более	не менее	не более	не более	не более
КТ837А	0,15	10	10	0,3	10	40	2,5	1,5
КТ837Б	0,15	10	10	0,3	20	80	2,5	1,5
КТ837В	0,15	10	10	0,3	50	150	2,5	1,5
КТ837Т	0,15	10	10	0,3	10	40	0,9	1,5
КТ837Д	0,15	10	10	0,3	20	80	0,9	1,5
КТ837Е	0,15	10	10	0,3	50	150	0,9	1,5
КТ837Ж	0,15	10	10	0,3	10	40	0,5	1,5
КТ837И	0,15	10	10	0,3	20	80	0,5	1,5
КТ837К	0,15	10	10	0,3	50	150	0,5	1,5
КТ837Л	0,15	10	10	0,3	10	40	2,5	1,5
КТ837М	0,15	10	10	0,3	20	80	2,5	1,5
КТ837Н	0,15	10	10	0,3	50	150	2,5	1,5
КТ837Л	0,15	10	10	0,3	10	40	0,9	1,5
КТ837Р	0,15	10	10	0,3	20	80	0,9	1,5
КТ837С	0,15	10	10	0,3	50	150	0,9	1,5
КТ837Т	0,15	10	10	0,3	10	40	0,5	1,5
КТ837У	0,15	10	10	0,3	20	80	0,5	1,5
КТ837Ф	0,15	10	10	0,3	50	150	0,5	1,5

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

медь - I,59 г в корпусе

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ837А-КТ837Ж, КТ837И-КТ837Н, КТ837П-КТ837Ф соответствуют техническим условиям АО.336.403ТУ.

ШТАМП ОТК

ОТК 275

Перепроверка произведена _____
дата

ШТАМП ОТК